- Лоладзе Н. Т. Влияние структуры исходного углеродсодержащего вещества на кинетику процесса алмазообразования. Проблемы сварки, металлургии и родственныз технологии // Ш межд. научно-техническая конференция, Проблемы сварки, металлургии и родственных технологий посв. 80-летию Патона Б.Е., Тбилиси, 15 – 18 декабря 1998, сб.докл. – Тбилиси: Ассоциация сварщиков Грузии, 1998 – с. 170 – 177.
- 8. Munson R.A. Surface Energies of Liquid Metal Interfaces with Carbon.//Carbon. -1967 v.5 p.471 474.
- 9. Безруков Г. Н., Поляков В. П., Лоладзе Н. Т., Мухаметкулова М. М.. Исследование кинетикикаталитического превращения графита в алмаз при различных термодинамических условияхсинтеза //Сверхтвердые материалы. –1982 –№ 2 с. 7 –10.
- 10. Кацай М. Я., Невструев Г. Ф., Мясников Е. П. Влияние концентрации углерода в сплаве на процессе синтеза и свойства алмазов // Сверхтвердые материалы 1985 № 2 с. 3 –7.

Поступила 05.06.09

УДК 621.921:661.65

# И. А. Боримский

Институт сверхтвердых материалов им. В. Н. Бакуля НАН Украины, г. Киев

## СИНТЕЗ КРИСТАЛЛОВ КУБИЧЕСКОГО НИТРИДА БОРА В ПРИСУТСТВИИ УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ – АЛМАЗА И ГРАФИТА

It is shown, that introduction of carbon materials - diamond and graphite in a reactionary charge mixture for cBN synthesis reduces the fractional conversion  $hBN \rightarrow cBN$  and influences a habitus of formed crystals. It is shown, that crystals of diamond with sizes more than 10 microns are not the crystallization centers at a cBN synthesis.

### Введение

Высокотвердые и термостойкие кристаллы кубического нитрида бора (*c*BN) [1] широко применяются при изготовлении различных инструментов, используемых при абразивной и лезвийной обработке широкого класса труднообрабатываемых материалов, таких как закаленные углеродистые, конструкционные и легированные стали, жаропрочные сплавы, высокотвердые наплавленные и напыленные покрытия, высокопрочные и износостойкие чугуны и др. [2].

*c*BN является синтетическим материалом, который получают из бор- и азотсодержащей реакционной шихты при высоких *p*,*T*-параметрах в области термодинамической стабильности [3; 4].

При синтезе *c*BN в зависимости от состава применяемой реакционной шихты, *p*,*T*-параметров, продолжительности синтеза, а также других факторов одновременно получают-ся кристаллы, различающиеся формой, размерами и физико-механическими свойствами [4].

На характеристики синтезируемых кристаллов *c*BN существенно влияют дополнительные центры кристаллизации. В качестве последних обычно применяют кристаллы *c*BN, которые вводят в реакционную шихту [5; 6]. Цель настоящей работы – исследовать возможность применения при синтезе *c*BN в качестве дополнительных центров кристаллизации порошки алмаза различной зернистости и изучить их влияние на характеристики получаемых кристаллов *c*BN.

#### Методика эксперимента

Синтез *c*BN осуществляли в аппарате высокого давления типа «наковальни с углублениями» с реакционным объемом 22 см<sup>3</sup> [7]. Продолжительность синтеза *c*BN во всех экспериментах составляла 240 с. Давление в реакционной ячейке аппарата высокого давления, которое при синтезе *c*BN определяли по калибровочной кривой аппарата, составляло 5,0– 5,5 ГПа. Температурные условия в реакционной ячейке устанавливали и контролировали по электрической мощности нагревания ячейки. Эксперименты проводили при мощности нагревания, которая обеспечивала наиболее равномерное распределение кристаллов *c*BN по объему реакционной шихты.

Применяли реакционную шихту [8], состоящую из гексагонального нитрида бора (HBN) и инициатора превращения, содержащего Mg и Mg(OH)<sub>2</sub> (далее – шихта 1) и шихту, состоящую из *h*BN и инициатора превращения Mg<sub>3</sub>N<sub>2</sub> (далее – шихта 2). Следует отметить, что в шихте 1 соединение Mg(OH)<sub>2</sub> имело вид покрытия на поверхности частиц Mg.

Шихту 1 применяли как в виде гомогенной смеси порошков-компонентов, так и в виде послойно расположенных чередующихся дисков, изготовленных из HBN и Mg+Mg(OH)<sub>2</sub>. Компоненты шихты в виде гомогенной смеси смешивали с порошками алмаза. При послойном расположении компонентов порошки алмаза смешивали с порошком *h*BN.

Шихту 2 применяли только в виде гомогенной смеси порошков-компонентов.

При выполнении исследований в качестве добавки к реакционной шихте применяли порошки алмаза ACM 14/10, ACM 28/20, ACM 60/40 и AC80 315/250, которые вводили в шихту в количестве 4 и 6 % ее массы.

Состав фаз, которые образовывались в спеках из реакционной шихты в процессе синтеза *c*BN, а также периоды кристаллической решетки отдельных фаз определяли по данным рентгеновского исследования с использованием стандартных методик. Дифрактограммы получали на автоматизированном рентгеновском аппарате ДРОН-3 в медном фильтрованном излучении.

Форму и размеры кристаллов *c*BN исследовали после извлечения из спеков по стандартным технологиям [9] с помощью оптического микроскопа XSP-139TP, оснащенного цифровым фотоаппаратом.

Площадь удельной поверхности применяемых микропорошков определяли с помощью гранулометра LMS-30 (Япония).

### Результаты

Установлено, что введение микропорошков алмаза в реакционную шихту 1 с инициатором превращения, содержащим свободный Mg, снижает степень превращения α гексагонального нитрида бора в кубический.

Результаты исследований, полученные при синтезе *c*BN с применением реакционной шихты, содержащей микропорошки алмаза в количестве 4 % ее массы, приведены в табл. 1 и показаны рис. 1. В табл. 1 также приведены степени превращения  $hBN \rightarrow cBN$ , полученные при прочих равных условиях без применения микропорошков алмаза, а также площади удельной поверхности  $F_{\rm vg}$  применявшихся микропорошков.

Взаимозависимость степени превращения *h*BN→*c*BN и зернистости микропорошков алмаза, введенных в реакционную шихту при синтезе *c*BN

Зернистость микропорошка алмаза	14/10	28/20	60/40	_
Площадь удельная поверхности, м <sup>2</sup> · см <sup>-3</sup>	0,630	0,311	0,153	—
Степень превращения, % (по массе)	2,1	18,8	22,4	34,8

Как следует из приведенных результатов, наблюдается прямая зависимость между степенью превращения *h*BN→*c*BN и зернистостью применявшихся микропорошков алмаза

и, следовательно, обратная зависимость между степенью превращения и площадью удельной поверхностью микропорошков.



Рис. 1. Зависимость степени превращения hBN→cBN от площади удельной поверхности введенных в реакционную шихту микропорошков алмаза

При введении в реакционную шихту микропорошков алмаза в количестве 6 % (по массе) кристаллизация *c*BN либо прекращалась (при применении порошка ACM 14/10), либо была незначительной (при применении порошка ACM 60/40), как показано на рис. 2.



Рис. 2. Общий вид изломов спеков после синтеза cBN, содержавших микропорошки алмаза ACM 14/10 (a) и ACM 60/40 (б) в количестве 6 % массы реакционной шихты

В результате рентгенографических исследований фазового состава инициаторов превращения, извлеченных из спеков после синтеза *c*BN, который осуществляли в присутствии микропорошков алмаза (исследовали спеки, полученные при послойном расположении компонентов реакционной шихты), выявлено следующее.

Синтез *c*BN из шихты, содержащей порошки алмаза, сопровождался превращением значительной части исходного металлического Mg в MgO (параметры решетки: a = e = c = 0,42147 нм) и MgC<sub>x</sub> (параметры решетки: a = 0,56991 нм, e = 0,52747 нм, c = 0,50792 нм). По мере уменьшения количества Mg и увеличения количества MgO и MgC<sub>x</sub>, которые вероятнее всего располагались преимущественно на поверхности частиц Mg, уменьшалась активность инициатора превращения, в результате чего степень превращения *h*BN→*c*BN сначала снижалась, а затем прекращалась.

По нашему мнению, MgO и MgC<sub>x</sub> образуются из металлического Mg в присутствии порошков алмаза следующим образом.

При высокотемпературном нагревании реакционной шихты в процессе синтеза *c*BN порошок алмаза взаимодействует с соединением  $Mg(OH)_2$  или водой, образующейся в случае распада  $Mg(OH)_2$  на MgO и  $H_2O$ , по реакции  $C + Mg(OH)_2 \rightarrow MgO + CO + H_2$  или  $C + H_2O \rightarrow CO+ H_2$ . Согласно второй реакций алмаз также взаимодействие с водой, адсорбированной реакционной шихтой, нагревателями и другими деталями контейнера. Образующийся в результате реакций водород высокой диффузионной подвижности покидает реакционную ячейку, а образовавшийся CO взаимодействует с Mg по реакции Mg + CO  $\rightarrow$  MgO + C. Далее образовавшийся аморфный углерод, который располагается на поверхности Mg, реагирует с последним по реакции Mg + XC  $\rightarrow$  MgC<sub>x</sub>. Возможность образования карбидов магния различного состава при взаимодействии Mg и C под высоком давлении была установлена ранее [10]. Очевидно, что скорость рассмотренных реакций прямо зависит от площади поверхности алмазного порошка, расположенного в шихте, что подтверждается экспериментами.

В качестве примера приведем состав инициатора превращения, который образовался при синтезе CBN из шихты, содержащей микропорошок ACM 14/10, % (по массе): MgO – 67; Mg – 9; BN – 12; MgC<sub>x</sub> – 11. Следует отметить, что Mg(OH)<sub>2</sub> в составе инициатора превращения не обнаружено.

Если инициатор превращения  $hBN \rightarrow cBN$  не содержал свободного магния, что наблюдалось при синтезе cBN с использованием в качестве инициатора превращения нитрида Mg<sub>3</sub>N<sub>2</sub> (шихта 2), введение в реакционную шихту порошков алмаза не приводило к снижению выхода cBN.

По мере уменьшения зернистости вводимых в реакционную шихту порошков алмаза со снижением степени превращения  $hBN \rightarrow cBN$  увеличивались размеры синтезируемых кристаллов *cBN* и количество кристаллов с хорошо сформированными отдельными гранями тетраэдра (рис. 3).



Рис. 3. Общий вид кристаллов cBN, полученных при использовании реакционной шихты, содержащей порошки ACM 14/10 и ACM 60/40 в исходном неклассифицированном по размерам состоянии (а, б), и порошки зернистости 125/100 (в, г), выделенные из продукта синтеза соответственно

Ранее кристаллы в форме тетраэдров не образовывались в процессе синтезе cBN при прочих равных условиях, но без применения порошков алмаза. Образование кристаллов cBN в форме тетраэдров возможно связано либо с меньшей стесненностью их роста в результате

значительного уменьшения количества центров кристаллизации, либо с изменением в процессе синтеза состава реакционной шихты.

Отметим, что в экспериментах не обнаруживалось наращивание cBN на применявшиеся микропорошки алмаза, как и на порошки алмаза более крупной зернистости – 315/250. Излом спека из реакционной шихты 1 после синтеза cBN, на котором виден один из кристаллов алмаза (кристалл желтого цвета), на поверхности которого, как и на поверхности остальных кристаллов алмаза, не выявлен наращенный слой из cBN, показан на рис. 4. Рядом с кристаллом алмаза видны кристаллы cBN темного цвета.



Рис. 4. Общий вид излома брикета из реакционной шихты, содержащей кристаллы AC80 315/125, после синтеза cBN

Таким образом, кристаллы алмаза размером более 10 мкм в условиях экспериментов не являлись центрами кристаллизации для *c*BN. Возможно, такими центрами могут быть кристаллы алмаза с меньшего размера, соизмеримые с размерами зародышей *c*BN, например, ультрадисперсные кристаллы алмаза.

При замене порошков алмаза, которые вводились в реакционную шихту при синтезе *с*ВN, порошками графита получили результаты, сравнимые с рассмотренными ранее.

## Выводы

1. Изучено влияние углеродных материалов – порошков алмаза и графита, вводимых в реакционную шихту для синтеза *c*BN, содержащую воду и свободный Mg, и установлено следующее:

введение углеродных материалов в реакционную шихту снижает степень превращения гексагонального нитрида бора в кубический;

существует обратная зависимость между степенью превращения гексагонального нитрида бора в кубический и площадью поверхности содержащегося в реакционной шихте углеродного материала;

снижение степени превращения гексагонального нитрида бора в кубический, наблюдаемое при введении в шихту углеродного материала, связано с превращением части магния в его соединения – оксид и карбид;

введение в реакционную шихту углеродных материалов сопровождается образованием кристаллов с хорошо сформированными отдельными гранями тетраэдра.

2. Кристаллы алмаза размером более 10 мкм в условиях экспериментов не являлись центрами кристаллизации при синтезе *c*BN.

## Литература

- 1. Полиморфные модификации углерода и нитрида бора: Справоч. изд. / А. В. Курдюмов, В. Г. Малоголовец, Н. В. Новиков и др. – М.: Металлургия, 1994. – 318 с.
- 2. Инструменты из сверхтвердых материалов / Под ред. Н. В. Новикова. М.: Машиностроение, 2005. – 556 с.

- 3. Corrigan F. R., Bandy F. P. Direct transitions among the allotropic forms of boron nitride at high pressure and temperatures // J. Chem. Phys. 1975. V. 63. N 9. P. 3812–3820.
- 4. Бурдина К. П. Химические аспекты синтеза кубического нитрида бора: Авторефер. дис. ... д-ра хим. наук / МГУ им. М. В. Ломоносова. М., 2000. 78 с.
- 5. Пат. 65367 А Україна, МПК<sup>7</sup> С10В21/06, С01В31/06. Спосіб отримання кубічного нітриду бору / О. І. Боримський, М. В. Новіков, І. О. Боримський. Заявл. 18.07.03; Опубл. 15.03.04; Бюл. № 3.
- Боримский И. А., Квасница В. Н., Шульженко А. А. Синтез и морфология кристаллов кубического нитрида бора, полученных с применением дополнительных центров кристаллизации // Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент – техника и технология его изготовления и применения: Сб. науч. тр. – К.: ИСМ им. В. Н. Бакуля НАН Украины, 2007. –Вып. 10. – С. 347–353.
- 7. Пат. 5087 Україна, МПК<sup>2</sup> В 01 Ј 3/06. Пристрій для створення високого тиску і високої температури / О. Й. Пріхна, О. І. Боримський, П. А. Нагорний. Опубл. 28.12.94; Бюл. № 7-1.
- 8. Пат. 4580 Україна, МПК<sup>5</sup> С 01 В 21/064. Спосіб приготування шихти для одержання порошків кубічного нітриду бору / О. І. Боримський, В. М. Давіденко, В. С. Лисанов та ін. Опубл. 28.12.94; Бюл. № 7-1.
- 9. Сверхтвердые материалы. Получение и применение: В 6 т. / Под общ. ред. Н. В. Новикова. К.: ИСМ им. В. Н. Бакуля, ИПЦ «АЛКОН» НАНУ / 2003. Т. 1. Синтез алмаза и подобных материалов. 320 с.
- Диаграмма состояния системы магний-углерод при давлении 7,7 ГПа / Шульженко А. А., Игнатьева И. Ю, Белявина Н. Н., Белоусов И. С. // Сверхтвердые матер. – 1988. – № 6. – С. 3–5.

Поступила 10.06.09

### УДК 669.017.14:539.89

## А. И. Боримский; В. Г. Делеви, П. А. Нагорный, кандидаты технических наук, Т. Ю. Чипенко

Институт сверхтвердых материалов им. В. Н. Бакуля НАН Украины, г. Киев

### ВЛИЯНИЕ ДАВЛЕНИЯ НА СТРУКТУРУ СЛОЯ КОНТАКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СПЛАВОВ систем Со-Fe-WC, Со-Fe-TaC И Со-Fe-NbC С ГРАФИТОМ

Special features of the influence of W, Ta and Nb on the interaction between the Co–Fe alloy and graphite at T = 1600 K and pressure of 4–5 GPa have been studied. It is shown that a pressure increase up to 5 GPa changes the pattern of the influence of W, Ta and Nb on the structure of the contact melting layer changing it from stable state (solid solution + graphite) to metastable state (solid solution + Me<sub>3</sub>C carbide).

### Введение

Эффективность синтеза алмаза при использовании растворителей углерода на основе сплавов системы Со–Fe существенно увеличивается при введении в их состав хрома [1]. Последний является карбидообразующим элементом, который в сплавах системы Me <sub>VIIIa FP</sub> – C стабилизирует карбиды типа Me<sub>3</sub>C, переводя сплавы из стабильного (твердый раствор + гра-